第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源修 正草案總說明

「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」(以下簡稱本公告)於一百零五年一月七日訂定,迄今未曾修正。有鑑於溫室氣體排放量盤查係溫室氣體減量之重要基礎工作,本次主要係新增第二批事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源,增訂全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量合計達二點五萬公噸二氧化碳當量以上之製造業為應辦理盤查登錄對象,爰修正本公告,並將名稱修正為「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」,其修正要點如下:

- 一、明確規定應盤查登錄排放量之主體為事業。(修正公告事項第 一項)
- 二、明確盤查登錄作業之執行期限並刪除已逾執行期限之規範。 (修正公告事項第二項)
- 三、 修正第一批各行業之製程別名、新增第二批列管事業之條件及 應每年辦理盤查登錄之認定條件。(修正公告事項第一項附表)

第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源修正 草案公告對照表

修正公告	現行公告	修正說明
主旨:修正「第一批應盤查	主旨:訂定「第一批應盤查	一、新增第二批納管事業,
登錄 溫室 氣體 排放	登錄溫室氣體排放	並明確規定盤查登錄
量之排放源」,名稱	量之排放源」, <u>並</u> 自	主體為事業,爰修正公
並修正為「事業應盤	即日起生效。	告名稱。
查登錄溫室氣體排		二、針對本次新增納管之第
放量之排放源」,除		二批事業應盤查登錄
公告事項一附表有		溫室氣體排放量之排
關第二批事業應盤		放源規定,定自一百十
查溫室氣體排放量		二年一月一日生效,以
之排放源規定自中		給予相當之緩衝期間。
華民國一百十二年		
<u>一月一日生效外</u> ,自		
即日生效。		
依據:溫室氣體減量及管理	依據:溫室氣體減量及管理	未修正。
法第十六條第一項。	法第十六條第一項。	
公告事項:	公告事項:	一、配合公告名稱修正,酌
一、事業應盤查登錄溫室氣	一、第一批應盤查登錄溫室	修文字。
體排放量之排放源,如	氣體排放量之排放源,	二、附表修正第一批各行業
附表。	如附表。	之製程別名、新增第二
		批列管事業之條件及
		應每年辦理盤查登錄
		之認定條件。
二、事業應於每年八月三十	二、本公告之排放源應於每	一、明確盤查登錄作業之執
一日前(含)完成前一	年八月底完成前一年	行期限,並配合公告名
年度全廠(場)溫室氣	度全廠(場)溫室氣體	稱修正,酌作文字修
體排放量盤查登錄作	排放量盤查登錄作業,	正。
業。	其中華民國一百零四	二、第一批排放源其一百零
	年之排放量,應於一百	四年排放量之盤查登
	零五年八月底前完成。	錄作業,已逾執行期
		限,爰刪除執行期限相
		關規定。

公告事項第一項附表修正草案對照表

修正規定			現行規定				說明		
附表	表			 附表:第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源				一、因二極體製造及發光	
批次	行業別	製程別	條件說明	批次	行業別	製程別	條件說明	計算說明	二極體製造非屬半導
_	發電業	汽力機組鍋爐發電程序	具備汽力機組鍋爐發電程 序且採用化石燃料者 <u>。</u>	字 令 。 青且 專壽 岡 开 。 且	發電業	汽力機組鍋 爐發電程序	具備汽力機組鍋 爐發電程序且採	一、 溫 氣 體	體業之積體電路晶圓 製造程序且非適用對 象,無庸特別規定,爰
	X 5 A	複循環機組發電程序	具備複循環機組發電程序且採用化石燃料者。			複循環機組	用化石燃料者 具備複循環機組		予删除二極體製造及 發光二極體製造相關
		一貫煉鋼鋼胚生產程序	包含煉鐵、煉鋼、熱軋、冷 軋等程序,且生產鋼胚者。			發電程序	發電程序且採用 化石燃料者。	設備者,應依規定	文字。 二、修正薄膜電晶體液晶
		電弧爐碳鋼鋼胚生產程序	包含電弧爐煉鋼程序、精煉爐及連續鑄造程序,且生產碳鋼鋼胚者。			一 貫 煉 鋼 鋼 胚生產程序	包含煉鐵、煉鋼、 熱軋、冷軋等程 序,且生產鋼胚	以號位全溫年盤錄溫排依算管為 進(氣放及 氣源列式編單行)體量登 體應計,	一下沙山
_	鋼鐵業	電弧爐不銹鋼鋼胚生產 程序	包含電弧爐煉鋼程序、轉爐、真空精煉爐及連續鑄造程序,且生產不銹鋼鋼胚者。		<u>第</u> 一 鋼鐵業	電弧爐碳鋼鋼胚生產程	I		字,以臻明確。 三、修正第一批各行業之 製程別,由於第一批 各行業項目之列管對
		H型鋼生產程序	包含加熱、軋製、噴砂及研磨程序,且生產 H 型鋼者。			序	且生產碳鋼鋼胚 者。		多主要係針對各製程 排放源,為臻明確,爰
		不銹鋼熱軋鋼捲(板)生產程序	包含加熱及軋製程序,且生產不銹鋼熱軋鋼捲(板)者。			電弧爐不銹鋼級上產	包含電弧爐煉鋼 程序、轉爐、真 空精煉爐及連續		將行業別之「其他設 備」修正為「各製程排 放源」。
_	石油煉製業	石油煉製程序	以礦產原油或油頁岩等為 原料,從事汽油、煤油、柴 油、潤滑油、石蠟、石油醚、	批		程序	鑄造程序,且生 產不銹鋼鋼胚 者。	判定全廠 (場)化 石燃料燃	四、新增第二批次事業列 管條件,以提升使用 電力產生之間接溫室
			有機溶劑或其他石油品之 提煉者。			H型鋼生產程 噴 序 序 鋼:	包含加熱、軋製、噴砂及研磨程	烧排溫年量溫年(氧量=(燃量產之放室排:室排公化/當物料、量直產氣排 氣放頓碳年年料使產或接生體放 體量二當)原、用品其	氣體排放量掌握度, 爰將化石燃料燃燒之
		磨製程及熟 其中熟料值 (CaO)、氧 氧化鋁(Al) (Fe ₂ O ₃)之 比例並經研 泥窯爐中, 所得以矽酸	熟料生產程序包含生料研磨製程及熟料燒成製程。				序,且生產H型鋼者。		直接排放及使用電力 之間接排放產生溫室
_	水泥業		其中熟料係指含氧化鈣 (CaO)、氧化矽(SiO ₂)、 氧化鋁(Al ₂ O ₃)及氧化鐵 (Fe ₂ O ₃)之原料,依適當			不銹鋼熱軋 鋼捲(板)生產 程序	包含加熱及軋製程序,且生產不銹鋼熱軋鋼捲		氣體年排放量合計達 二點五萬公噸二氧化 碳當量之製造業納入 管制。
			比例並經研磨後投入於水 泥窯爐中,燒至部分熔融 所得以矽酸鈣為主要礦物 成分之水硬性膠凝物質。		石油煉製業	石油煉製程 序	以礦產原油或油 頁岩等為原料, 從事汽油、煤油、 柴油、潤滑油、		五、計算說明調整為備註, 其修正如下: (一)修正計算說明一,配 合公告名稱修正盤
_	半導體業	積體電路晶圓製造程序	包含經由物理氣相沈積、 化學氣相沈積、光阻、微 影、蝕刻、擴散、離子植入、		衣木	/1	石蠟、石油醚、 有機溶劑或其他 石油 品之 提煉		查登錄主體為事 業,爰酌修文字。 (二)計算說明二及三,整

				氧化與熱處理等製程;僅				Τ
				從事晶圓封裝、磊晶、光罩				
				製造、導線架製造等作業				
				者或製程中確實未使用含				
				氟溫室氣體者,非屬本公				t
				告之適用對象。				
				薄膜電晶體液晶顯示器之				
			日从兹吡西日酬二从咕	製程中,包含擴散、薄膜、				
	_	薄膜電晶體液	具備薄膜電晶體元件陣	黄光顯影、蝕刻或彩色濾				
	_	晶顯示器業	列基板或彩色濾光片生	光片等程序; 製程中確實				
			產程序	<u>未</u> 使用含氟溫室氣體 <u>者</u> ,				
				非屬本公告之適用對象。		水泥業	具備熟料生	
				全廠(場)化石燃料燃燒之		小儿未	產程序	
	_	 各行業	 各製程排放源	直接排放產生溫室氣體年				
		台11 未	<u> </u>	排放量達二點五萬公噸二				
				氧化碳當量者。				
				全廠(場)化石燃料燃燒之				
				直接排放及使用電力之間				
	<u>=</u>	製造業	各製程排放源	接排放產生溫室氣體年排				
				放量合計達二點五萬公頓				Ļ
				二氧化碳當量者。				
			備註	as and a part of the second of				1
		=		依規定以管制編號為單位,				
			體年排放量盤查及登錄。					
=				料燃燒之直接溫室氣體年排				
			温室氣體年排放量:	J 8 .				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		燃燒之直接溫室氣體年排	及重:		半導體	建	
	1. 公式:		八晒一与儿叫出旦/生)			十号版	積 體 電 路 晶 圓 製 造 程 序	
			公頓二氧化碳當量/年)	中央主管機關認定之操作量		未	图 表 迈 柱 / 7	
	• `							
	(公噸、公秉或千立方公尺)× 排放係數 <u>(公斤/兆焦耳)×4.1868×10⁻⁹×低</u>							
	<u>他然值(</u>							
	2. //\ (1/	77年1 / 然生民用	王 庄阳庄里况开门红	八十日水明心人~亦「里			1	1

主管機關 認定之操 作量(公 噸、公秉 或千立方 公尺/ 年) X排放 係數(公 噸 / 公 噸、公秉 / 公噸或 千立方公 尺 / 公 頓)×溫暖 化潛勢 三、原(物) 料、燃料 使用量、 產品產量 或其他經 中央主管 機關認定 之操作 量,應依 前一年度 實際操作 量計算 之。但公 告後始設 立之排放 源,其操 作量以最 大設計值 為準。

他經中央

者。

熟料生產程序包

含生料研磨製程

及熟料燒成製

程。其中熟料係

指含氧化鈣

(CaO)、氧化矽

(SiO₂)、氧化鋁

(Al₂O₃)及氧化

鐵(Fe₂O₃)之原

料,依適當比例

並經研磨後投入

於水泥窯爐中,

燒至部分熔融所

得以矽酸鈣為主

要礦物成分之水

硬性膠凝物質。

包含經由物理氣

相沈積、化學氣

相沈積、光阻、

微影、蝕刻、擴

散、離子植入、

氧化與熱處理等

製程;僅從事晶

圓封裝、磊晶、

光罩製造、導線

架製造、二極體

製造及發光二極

體製造等作業者

或製程中確實未

使用含氟温室氣

體者,非屬本公

告之適用對象。

薄膜電晶體液晶

顯示器之製程

中,包含擴散、

薄膜、黄光顯影、

蝕刻或彩色濾光

片等程序; 製程

具備薄膜電

晶體元件陣

列基板或彩

色濾光片生

產程序

- (四)新增備註二(三), 明定進行溫室氣體 排放量計算時之化 石燃料排放係數及 電力排碳係數之計 算依據。
- (五)新增備註三,考量本 公告列管各排放源 之目的係為穩定掌 握溫室氣體排放量 較高者,惟依現行 計算說明三,第一 批各行業其他設備 是否達列管條件, 係以前一年度之操 作值據以計算,使 得實務上列管對象 浮動性高而不易掌 握。爰此,增訂達第 一批各行業各製程 排放源或第二批製 造業各製程排放源 公告條件之事業, 於公告生效當年及 後續年度皆應辦理 盤查登錄作業,以 臻明確。
- (六)新增備註四,為能有

- <u>時之發熱量。</u> 5.4.1868×10⁻⁹為單位轉換因子,單位為兆焦耳/千卡。
- (二)全廠(場)使用電力之間接溫室氣體年排放量:

應以應盤查登錄年度之情形計算之。

<u>1.</u> 公式:

=電力使用量(千度)×電力排碳係數(公噸二氧化碳當量/千度)

3. 排放係數係指燃料燃燒後,每單位熱值所產生之溫室氣體排放量。

4. 低位熱值係指一單位燃料完全燃燒時,其燃燒產物中之水蒸氣以氣態存在

器業

薄膜電

晶 體 液

晶顯示

2. 電力使用量應以應盤查登錄年度之實際用電量計算。			中確實使用含氟	效列管產生溫室氣
(三) 化石燃料之排放係數及低位熱值應依行政院環境保護署公告數值計算之;			溫室氣體,亦屬	體之大型排放源,
電力排碳係數應依經濟部最新公告之電力排碳係數計算之。			本公告之適用對	並考量事業產能變
三、自公告生效日當年度起,事業達第一批各行業各製程排放源或第二批製造業			象。	動情形,規劃第一
各製程排放源之條件者,每年應依本公告事項二辦理。事業同屬公告事項一				批各行業各製程排
各批次應盤查登錄溫室氣體排放量者,依首次公告批次之應執行盤查登錄溫				放源或第二批製造
室氣體排放量期限辦理。			全廠(場)化石	業以連續三年度溫
四、事業為第一批各行業各製程排放源或第二批製造業各製程排放源,其全廠			燃料燃燒之直接	室氣體年排放量低
(場)化石燃料燃燒之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放			排放產生溫室氣	於公告條件之事
量合計值連續三年度小於二點五萬公噸二氧化碳當量者,得停止辦理盤查登	各行業	其他設備	體年排放量達	業,得停止辦理盤
錄溫室氣體排放量作業。			二・五萬公頓二	查登錄。
			氧化碳當量。	